

國立交通大學

電子物理研究所

碩士論文

砷化銦/砷化銦鎵量子點中砷化銦厚度對
缺陷的電子放射與捕捉影響之研究



InAs Thickness Dependence of Carrier Emission and Capture
from Defects in InAs/InGaAs dots-in-a-well Structure

研究生：林士傑

指導教授：陳振芳 博士

中華民國九十三年六月

砷化銦/砷化銦鎵量子點中砷化銦厚度對

缺陷的電子放射與捕捉影響之研究

InAs Thickness Dependence of Carrier Emission and Capture
from Defects in InAs/InGaAs dots-in-a-well Structure

研究生：林士傑

Student : Shih-Chieh Lin

指導教授：陳振芳 博士

Advisor : Dr. Jenn-Fang Chen



A Thesis

Submitted to the Institute of Electrophysics

College of Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science

in

Electrophysics

June 2004

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月